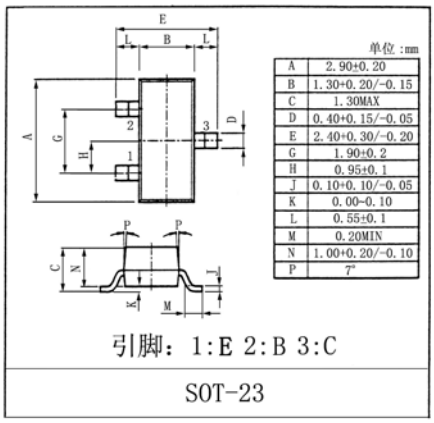
S8550M(3CG8550M)　　硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于功率放大电路。/Purpose: Power amplifier applications.
特点:与 S8050M(3DG8050M)互补。/Features: Complementary pair with S8050M(3DG8050M).

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CBO}	-40	V
V_{CEO}	-25	V
V_{EBO}	-6.0	V
I_C	-800	mA
I_B	-200	mA
P_C	450	mW
T_j	150	℃
T_{stg}	-65～150	℃

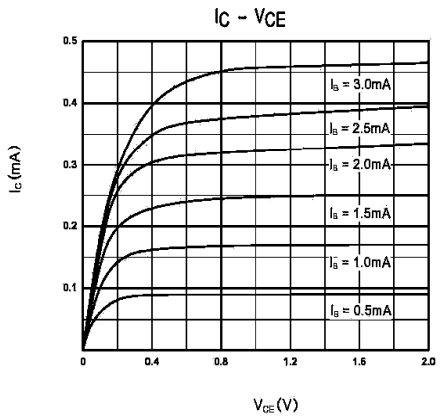


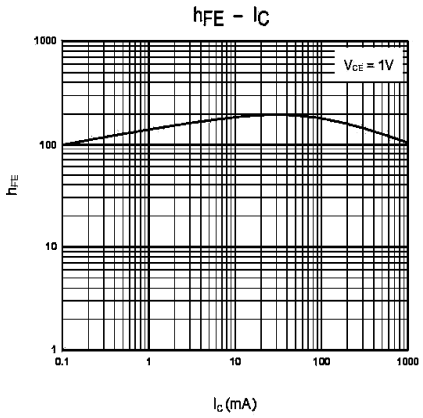
电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

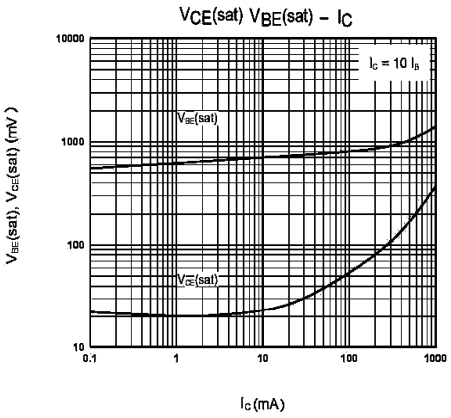
参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating 最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
V_{CBO}	I_C=-0.1mA I_E=0	-40			V
V_{CEO}	I_C=-2.0mA I_B=0	-25			V
V_{EBO}	I_E=-0.1mA I_C=0	-6.0			V
I_{CBO}	V_{CB}=-35V I_E=0			-0.1	μA
I_{EBO}	V_{EB}=-6.0V I_C=0			-0.1	μA
$h_{FE(1)}$	V_{CE}=-1.0V I_C=-100mA	85		300	
$h_{FE(2)}$	V_{CE}=-1.0V I_C=-500mA	40			
$h_{FE(3)}$	V_{CE}=-1.0V I_C=-5.0mA	45			
$V_{CE(sat)}$	I_C=-500mA I_B=-50mA		-0.28	-0.6	V
$V_{BE(sat)}$	I_C=-500mA I_B=-50mA		-0.98	-1.2	V
V_{BE}	V_{CE}=-1.0V I_C=-10mA		-0.66	-1.0	V
f_T	V_{CE}=-10V I_C=-50mA	100	200		MHz
C_{ob}	V_{CB}=-10V I_E=0 f=1.0MHz		15		pF

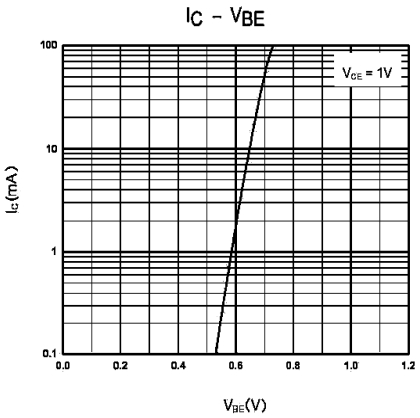
$h_{FE(1)}$分档、印章/$h_{FE(1)}$ classifications、Marking:

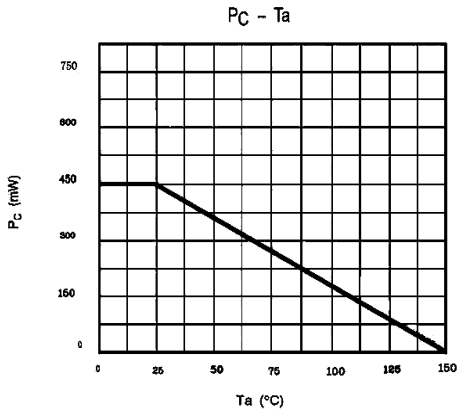
$h_{FE(1)}$分档 $h_{FE(1)}$ Classifications	B	C	D
$h_{FE(1)}$范围 $h_{FE(1)}$ Range	85～160	120～200	160～300
印章 Marking	HY4B	HY4C	HY4D

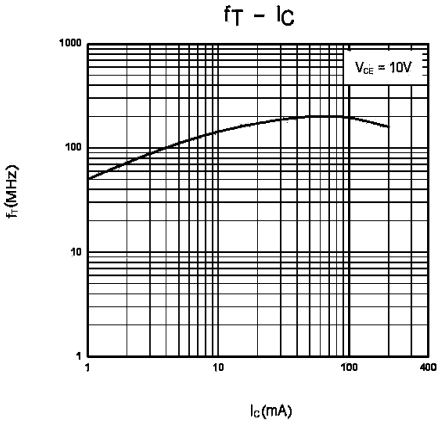

Ic - VCE
Ic (mA)
VCE (V)
IB = 3.0mA
IB = 2.5mA
IB = 2.0mA
IB = 1.5mA
IB = 1.0mA
IB = 0.5mA


hFE - Ic
hFE
Ic (mA)
VCE = 1V


VCE(sat) VBE(sat) - Ic
VBE(sat), VCE(sat) (mV)
Ic (mA)
Ic = 10 IB
VBE(sat)
VCE(sat)


Ic - VBE
Ic (mA)
VBE(V)
VCE = 1V


PC - Ta
PC (mW)
Ta (°C)


fT - Ic
fT (MHz)
Ic (mA)
VCE = 10V